# D-T中子照射下含硼聚乙烯球泄漏 能谱测量

郭海萍,安 力,牟云峰,王新华,陈 渊

(中国工程物理研究院 核物理与化学研究所,四川 绵阳 621900)

摘要:为了更清楚地了解含硼聚乙烯的屏蔽性能,用反冲电子法测量了 D-T 中子照射下的不同 B<sub>4</sub>C 含量的聚乙烯球的泄漏 能谱,并用 MCNP/4A 程序和 ENDF/B- 库数据进行模拟计算。实验测量值和 计算值在误差范围内符合得较好。

关键词:含硼聚乙烯; 泄漏 能谱; D-T中子; MCNP/4A 程序 中图分类号:0571.5 文献标识码:A 文章编号:1000-6931(2005)03-0198-04

## Measurement of Leakage Gamma Spectra in Boron-containing-PE Spheres by D-T Neutron

GUO Hai-ping, AN Li, MOU Yun-feng, WANG Xin-hua, CHEN Yuan (China Academy of Engineering Physics, P. O. Box 919-213, Mianyang 621900, China)

Abstract: The leakage gamma spectra from PE spheres with different percentage of  $B_4C$  and different thickness irradiated by D-T neutron were measured. The leakage gamma spectra were calculated using MCNP/4A code with ENDF/B- database. Comparing with the experiment, they have good consistency within the error range.

Key words: boron-containing-PE; leakage gamma spectra; D-T neutron; MCNP/ 4A code

含硼聚乙烯是一种相对廉价的中子屏蔽材 料,对其中子屏蔽特性已进行过一维基准实验。 与其他中子屏蔽材料一样,该材料在中子的作 用下产生 射线。相对于屏蔽中子而言,射 线是二级剂量。由于硼的中子吸收截面远大于 氢,为了对含硼聚乙烯材料的性能有全面的了 解,进行 D-T 中子照射下含硼聚乙烯材料泄漏 能谱实验研究很有必要。

### 1 实验原理和方法 本实验测量的 泄漏能谱是指 D-T 中子

进入球体内与物质因发生非弹散射产生的非弹

、因发生(n,)反应产生的俘获 及其他反应 的伴随 的总合。其中,对于 14 MeV 中子反 应截面比较大的反应有:<sup>10</sup>Be(n,n), = 3.5 ×  $10^{-25}$  cm<sup>2</sup>;<sup>11</sup>B(n,n), = 2.7 × $10^{-25}$  cm<sup>2</sup>;C(n, n), = 4.2 × $10^{-25}$  cm<sup>2</sup>;m C(n,)( = 1.18 ×  $10^{-28}$  cm<sup>2</sup>)和 H(n,)( = 2.98 × $10^{-29}$  cm<sup>2</sup>)截 面比较小。<sup>10</sup>B 和<sup>11</sup>B 只是对低能中子才有(n,)反应。

实验测量的是康普顿反冲电子谱,通过解 逆矩阵方法得到 谱。设实验测量的康普顿反

收稿日期:2003-11-12;修回日期:2004-03-09

作者简介:郭海萍(1965 ---),女,内蒙古自治区丰镇人,副研究员,实验核物理专业

冲电子谱为 J,把反冲电子谱和连续的 能谱

分成 *m* 个能量间隔,则第 *i* 个间隔内的反冲 电子数为:

$$J_i = \int_{j=i}^{\infty} f_{ij} j \qquad (1)$$

写成矩阵为:

$$J = F \tag{1}$$

求逆矩阵:

$$= \mathbf{F}^{-1} \mathbf{J} \tag{3}$$

式中:f<sub>3</sub>为 NE-213 闪烁体对单能 射线的响应函数。

NE-213 闪烁体单能 射线的响应函数用 MARTHA 程序计算。

#### 2 实验装置及测量

#### 2.1 样品球

含硼聚乙烯(PE)球作为样品,它是用不同 比例的 B<sub>4</sub>C 和 CH<sub>2</sub> 粉末压制成型,再机械加工 成 3 套尺寸相同的可组合的球壳系统。每套有 4 层球壳,每层球壳由上、下两个半球壳组成。 由于粉末搅拌不均匀或压制松紧程度不同,各 层的密度有可能不同。即使是同一层密度也可 能不均匀,因此,每层只能给出一个平均密度。 B<sub>4</sub>C 的质量百分比分别为 0、10 %和 50 %,相应 于吸收与慢化原子比为 0、3.6 %和 31.1 %。3 套样品球的精确尺寸及密度列于表 1。

层数	成分	内径/ cm	外径/ cm	密度/ (g cm <sup>-3</sup> )
第1层	PE	6.01	16.12	0.789
	$PE+10\ \%B_4C$	6.04	16.16	0.845
	$PE+50\ \%B_4C$	6.05	16.10	1.198
第2层	PE	16.25	26.10	0.769
	$PE+10\ \%B_4C$	16.22	26.15	0.851
	$PE+50\ \%B_4C$	16.22	26.12	1.211
第3层	PE	26.23	36.10	0.779
	$PE+10\ \%B_4C$	26.22	36.12	0.825
	$PE+50\ \%B_4C$	26.23	36.12	1.207
第4层	PE	36.21	47.62	0.823
	$PE+10\ \%B_4C$	36.26	47.63	0.860
	$PE+50\ \%B_4C$	36.25	47.64	1.301

表 1 实验样品的尺寸及密度 Table 1 Dimension and density of the sphere shell

注:内、外径数据为样品加工单位给出的原始数据

7

本工作选用了 7 种组合球体,分别是:由 3 种不同 B<sub>4</sub>C 百分比材料的第 3、4 层组成的厚 10 cm 的 3 个球体;由 B<sub>4</sub>C 百分比为 50 %材料 的第 2、3、4 层组成的厚 15 cm 的 1 个球体;由 3 种不同 B<sub>4</sub>C 百分比的第 1、2、3、4 层组成的厚 20 cm 的 3 个球体。

球体由上、下两半球组成,在两个半球的剖 面及1个半球的对称轴线上各有1条  $\phi$ 3.6 cm 的彼此相互垂直的孔道,其中一条为靶室孔道, 另一条为球内参数测量孔道,测量孔道不用时 可以用相同材料的塞块填充。每一套球都要测 量 本底和样品的 泄漏能谱。

#### 2.2 靶室系统

实验在 ns-200 加速器上进行。靶室为单管铝制的,结构比较简单。靶用芯靶,氚靶位于 实验球体球心,靶的活性区  $\phi$ 10 mm。靶衬材 料为真空无氧铜,尺寸为  $\phi$ 20 mm。中子源强 用 T(d,n) 反应的伴随 粒子监视,金硅面垒 半导体探测器位于与 D<sup>+</sup> 束成 178.9 位置上。 实验时的中子源强为 1 ×10<sup>8</sup> s<sup>-1</sup>。

#### 2.3 实验布置及测量

实验布置示于图 1。靶心距探头约 3.5 m, NE 213 谱仪探头用铅砖屏蔽。采用脉冲形状 甄别技术进行 n、 分辨。对于环境散射 本 底,用倒影锥的方法进行测量,即影锥大头朝样 品。影锥由铁饼和聚乙烯锥体组成,铁饼尺寸 为  $\phi_{20}$  cm ×11 cm,聚乙烯锥体大头为  $\phi_{20}$  cm, 小头为  $\phi_{5.5}$  cm,长 70 cm。影锥放置的位置为 探测器看不到、直接从样品发射 射线的位置。 测量样品得到的泄漏 射线谱中含有靶室材料 被活化而产生的 射线的贡献,这部分 射线



以扣除<sup>[2]</sup>:对于由靶室来的 本底,先测量只由 靶室产生的 射线谱,然后作为输入谱,用 MCNP程序进行输运模拟计算,其结果作为本 底从测量的泄漏 能谱中加以扣除。

2.4 实验测量

泄漏能谱分高能段(2.5~10.0 MeV)和 低能段(0.4~3.5 MeV)两段进行测量。首先 测量有样品球的 泄漏能谱,然后加影锥环境 散射本底。先后测量了3种B4C质量百分比 的7个实验球体(模型)的 泄漏能谱。为了保 证测量过程中探测器和影锥的相对固定,7个 实验球体的大小相同,但厚度不同。测量能谱 的同时用金硅面垒半导体探测器记录 粒子, 两段测量用伴随 粒子归一。测量 射线的能 量范围是 0.4~10 MeV。

#### 3 数据处理

实验中,NE-213 谱仪和 MCA 程序测量所 得到的是康谱顿反冲电子谱,要得到 射线能 谱就必须进行相关的数据处理。MCA 中的反 冲电子谱以.CHN 形式存在,它是不可读文件, 经 FOR TRAN 编译的 CHN.FOR 程序可将其 转化成可解读的十进制文件。为了确保测量过 程中 射线的高低能区都能被有效地测出,因 而,在实验中分为高低能区分别测量。将实验 测量的康普顿反冲电子谱剥去环境本底,用 <sup>60</sup>Co 源对高、低两段反冲电子谱进行能量刻 度并用伴随 粒子归一。两段电子谱衔接能区 的不一致性一般小于 3 %。通过解逆矩阵方法 得到 谱。NE-213 闪烁体单能 射线的响应 函数用 MARTHA 程序计算。

#### 4 结果与讨论

7

对 3 种含硼量的聚乙烯球共 7 个实验球体 测量所得的泄漏 能谱与用 MCNP/4A 程序 和 EDNF/B- 库数据对其模拟计算的结果分 别示于图 2~5 中。在图 2~5 中,纵坐标为归 一到一个源中子和相同探测器面积下的 射线 相对注量。

从图 2 可以看出,实验值和计算值在误差 范围内符合得较好。图 3 是相同厚度不同含硼 量泄漏 谱测量值的比较。可以看出,纯聚乙 烯球在 2.3 MeV 处有一个峰,而含硼聚乙烯球 却没有,这说明在聚乙烯球中氢的慢化起主要 作用,中子被慢化后,主要是低能中子对氢的





(n,)反应。而在含硼聚乙烯球中,主要是硼 起吸收作用。硼对低能中子的反应截面比较 大,在还没有发生氢的(n,)反应之前低能中 子基本已被硼完全吸收,因此,在 2.3 MeV 处 看不到这一峰值。在约 4.5 MeV 处的峰主要 是碳的非弹散射 射线。从含硼量的变化上 看,B4C质量百分比从 10%到 50%,泄漏能谱 的积分量变化很小。图 4 是 B4C 质量百分比 为 50%、厚度为 10、15、20 cm 的聚乙烯球的泄 漏 能谱。从图 4 可以看出厚度的变化对能谱 的影响也不是很大,泄漏能谱的积分量变化也 很小。图 5 为聚乙烯球泄漏 能谱。从图 5 可 以看出,厚度的变化在2.3 MeV处起到了一定 的作用,厚度越大,氢的慢化、吸收越强,表现在

7

氢的(n,)反应的峰值的幅度也就越大。在以 往对含硼聚乙烯的中子屏蔽性能研究中观测 到,在 B<sub>4</sub>C 质量百分比为 10%、厚度为 15 cm 时,含硼聚乙烯对 14 MeV 中子的屏蔽效果已 达到要求。在此基础上再增加含硼量或厚度, 中子的积分泄漏量基本不发生变化。本实验表 明,射线的积分泄漏量也不发生变化。从以 上的分析可以看出,作为一维基准实验,本实验 的结果与用MCNP/4A程序和 ENDF/B- 库 数据的计算结果在误差范围内一致。

#### 5 实验结果误差

实验结果误差主要包括中子源强监测误 差,小于2.5%;NE-213探测器响应函数的计 算误差为3%~4%;测量系统的能量刻度误差 约为1%;n/分辨误差约为1%;本底扣不准 误差小于2%;解谱过程中的误差为3%。总的 实验误差为5%~6%。

#### 参考文献:

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

- [1] 复旦大学、清华大学、四川大学合编. 核物理实验 方法(下)[M]. 北京:原子能出版社,1982.23~24.
- [2] 陈 渊,郭海萍,安 力,等. 钒球 14 MeV 中子
  的泄漏能谱测量[J]. 原子能科学技术,2002,36
  (2):157~159.
- [3] 牟云峰,陈 渊,安 力.D-T中子照射铁球 射
  线角通量谱测量[J].原子能科学技术,2000,34
  (增刊):113~116.